

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-302182

(43)Date of publication of application : 16.11.1993

(51)Int.Cl.

C23F 4/00
F03G 7/00
H01L 21/302
H02N 1/00

(21)Application number : 04-302734

(71)Applicant : FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 13.11.1992

(72)Inventor : GOTOU TOMOAKI

(30)Priority

Priority number : 04 36779 Priority date : 25.02.1992 Priority country : JP

(54) PRODUCTION OF COMB-SHAPED ACTUATOR

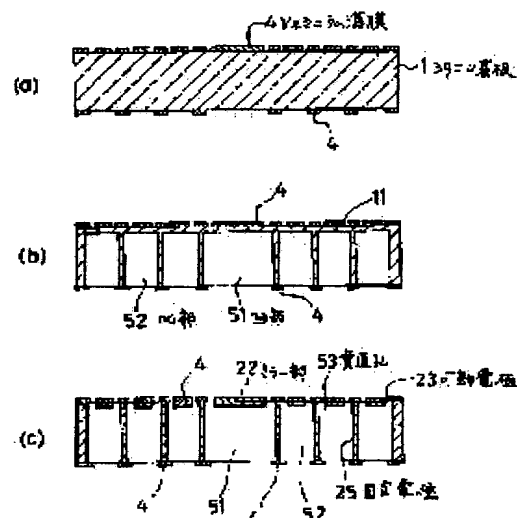
(57)Abstract:

PURPOSE: To control the interelectrode gap to the μm order by forming the combined comb-shaped movable electrode and fixed electrode from a substrate.

CONSTITUTION: A silicon substrate 1 coated with an Al mask 4 or a silver oxide-film mask is dry-etched with a mixture of gaseous SF_6 and O_2 and worked.

Consequently, the recesses 51 and 52 having a vertical side wall and a throughhole 53 are formed, and a comb-shaped actuator consisting of a movable part having optional shape and size and a fixed part is obtained.

Further, a silicon oxide film as an etching stop layer is embedded in the substrate to attain higher-precision working.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 23.06.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3178123

[Date of registration] 13.04.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-302182

(43)公開日 平成5年(1993)11月16日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

C 2 3 F 4/00

E 8414-4K

F 0 3 G 7/00

H

H 0 1 L 21/302

F 8518-4M

H 0 2 N 1/00

8525-5H

審査請求 未請求 請求項の数9(全 8 頁)

(21)出願番号 特願平4-302734

(22)出願日 平成4年(1992)11月13日

(31)優先権主張番号 特願平4-36779

(32)優先日 平4(1992)2月25日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 後藤 友彰

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

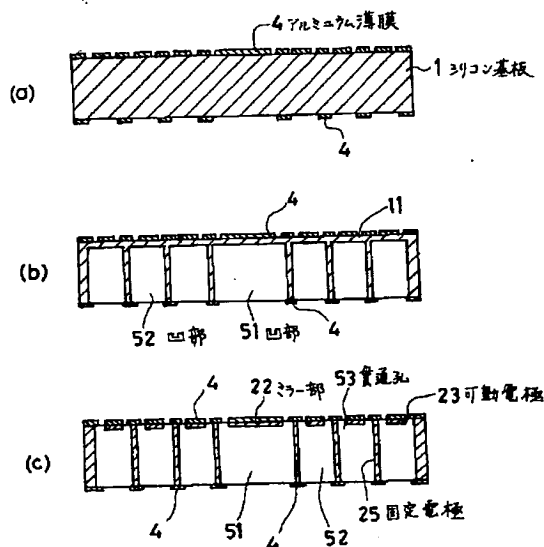
(74)代理人 弁理士 山口 巖

(54)【発明の名称】 櫛歯式アクチュエータの製造方法

(57)【要約】

【目的】櫛歯式の可動電極と固定電極を組み合わされた状態で基体から作り出して、電極間隙を μm オーダーにすることができるようにする。

【構成】SF₆ガスとO₂ガスの混合ガスを用いてのドライエッチングによりAlマスクあるいはシリコン酸化膜マスクを設けたシリコン基体を加工する。これにより垂直な側壁をもつ凹部ないし貫通孔が形成でき、任意の形状、寸法の可動部と固定部とからなる櫛歯式アクチュエータが得られる。さらに、エッチングストップ層としてのシリコン酸化膜をシリコン基体に埋設することにより一層高精度の加工が可能になる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一つのシリコン基体の両面からの加工により狭い間隔を介して組合わせられた櫛歯式の可動電極と櫛歯式の固定電極をそれぞれ有する可動部と固定部を作り出す櫛歯式アクチュエータの製造方法において、加工を六弗化硫黄と酸素の混合ガスを用いたドライエッチングにより行うことを特徴とする櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項2】ドライエッチングの際の両面のマスクがアルミニウム薄膜よりなる請求項1記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項3】ドライエッチングの際の両面のマスクがシリコン酸化膜よりなる請求項1記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項4】可動電極と固定電極の間隙を形成する加工の際のマスクのみがシリコン酸化膜よりなる請求項1記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項5】シリコン酸化膜よりなるエッチングストップ層を介して重ねられた二つの部分を有するシリコン基体を用い、両面からそのエッチングストップ層まで達する凹部を形成したのち、凹部間に残存したエッチングストップ層のシリコン酸化膜を除去する請求項1ないし4のいずれかに記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項6】エッチングストップ層を介して重ねられた二つの部分の双方が単結晶シリコンよりなる請求項5記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項7】中間層を介して重ねられた二つの部分の一方が単結晶シリコン、他方が多結晶シリコンよりなる請求項5記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項8】シリコン基体の一面からのドライエッチングによる加工によって形成される凹部の開口面積に差のある場合に、開口面積の大きい凹部の形成される部分をシリコン基体のそれに覆われた部分がサイドエッチングにより残存しない程度の細い幅のマスクにより複数のエッチング領域に分割する請求項1ないし7のいずれかに記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【請求項9】一面からのドライエッチングによる加工によって形成される凹部の開口面積に差のある場合に、開口面積の大きい凹部を形成と開口面積の小さい凹部の形成を別のドライエッチング工程で行い、それぞれの工程において加工の対象とならない部分をマスクによって覆う請求項1ないし7のいずれかに記載の櫛歯式アクチュエータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、1個のシリコン基体を加工して櫛歯式の固定電極と可動電極とが組合わせられた状態で作製する櫛歯式アクチュエータの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】例えば光を走査するためのミラーの駆動に用いる櫛歯式アクチュエータは、図2に示すような可動部21のミラー22と一体に形成している櫛歯式可動電極23が、固定部24の櫛歯式固定電極25の間隙に、拡大図Aに示すように組合わされており、可動部21を支持部26により支持する固定部24がガラス基板27の上に取り付けられている。そして、表面に絶縁膜を被着した両電極23、25の間に電圧を印加することにより生ずる静電氣的な力で可動部21が動き、ミラー22が回転する。このようなアクチュエータでは、可動電極23と固定電極25とができれば5 μ m程度の間隙をもって近接していることが要求される。従って、別個に加工された可動部21と固定部24を可動電極23と固定電極25が変形しないで噛み合うように組合わせることは難しいので、できれば一つの基体から両者が μ mオーダーの間隙を介して組合わされた状態で加工することが望ましい。そのためには、微細加工が可能なシリコン基体から作り出すことが考えられる。

【0003】シリコン基体に、両者から加工を施し、所定の大きさの櫛歯式アクチュエータを組合わされた状態で製造する従来の方法は、図3(a)に示すように、単結晶シリコン基板1の両面にシリコン酸化膜2およびシリコン窒化膜3を被加工部が露出するように被着し、図3(b)に示すように、まず浅掘り側からアルカリ系溶液でシリコン基板1をエッチングして凹部を形成し、つぎに図3(c)に示すように、深掘り側から弗酸系溶液でエッチングして凹部および貫通孔を形成し、ミラー部22および可動電極23と固定電極25とを作り出そうというものである。あるいは、図4(a)、(b)、(c)に示すように、まず深掘り側から上記と同様に加工を行い、つぎに浅掘り側を加工して櫛歯式アクチュエータを製造しようとするものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記のような湿式エッチングでシリコン基体を加工する方法では、エッチング液に弗酸系溶液を用いるため、エッチングが等方的に進行し、図示のような丸みのついた形状にしか加工できない。このことは固定電極25と可動電極23とをできるだけ近接して組合わせたい櫛歯式アクチュエータの製造方法としては不適である。そこで、垂直な側壁を形成するために、単結晶シリコン基板の面方位ごとにエッチング速度が異なることを利用したアルカリ系溶液により加工を行えば、面方位に応じて正確な加工が可能であるが、形状が面方位に依存するため、任意の大きさで、任意の形状の櫛歯式アクチュエータを形成することは困難である。また、シリコン基板の面方位が限定されるため、設計上で限定条件が多くなるという欠点がある。

【0005】さらに、湿式エッチングにおいてはマスクの厚さに限度があるため深いエッチングができず、また、加工する側と反対側の面を保護する必要があるが、深い加工のためのエッチング操作に耐える保護を行うこ

3

とも困難である。従って、湿式エッチングは深い加工を要する櫛歯式アクチュエータの製造には利用できないという欠点がある。

【0006】本発明の目的は、上述の欠点を除去し、シリコン基板を加工して所定の寸法形状を有する固定部と可動部を同時に精度よく形成することのできる櫛歯式アクチュエータの製造方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明は、一つのシリコン基体の両面からの加工により狭い間隔を介して組合せられる櫛歯式の可動電極と櫛歯式の固定電極をそれぞれ有する可動部と固定部を作り出す櫛歯式アクチュエータの製造方法において、加工を六弗化硫黄と酸素の混合ガスを用いたドライエッチングにより行うものとする。そしてドライエッチングの際のマスクが両面共アルミニウム薄膜よりなっても、あるいはシリコン酸化膜よりなってもよい。また可動電極と固定電極の間の間隔の加工の際のマスクのみシリコン酸化膜よりなることも有効である。さらに、シリコン酸化膜よりなるエッチングストップ層を介して重ねられた二つの部分を有するシリコン基体を用い、両面からそのエッチングストップ層まで達する凹部を形成したのち、凹部間に残存するエッチングストップ層のシリコン酸化膜を除去することも有効である。そのエッチングストップ層を介して重ねられた二つの部分は、双方が単結晶シリコンよりなってもよく、一方が単結晶シリコン、他方が多結晶シリコンよりなってもよい。

【0008】そのほか、シリコン基体の一面からのドライエッチングによる加工によって形成される凹部の開口面積に差のある場合に、開口面積の大きい凹部の形成される部分をシリコン基体のそれに覆われた部分がサイドエッチングにより残存しない程度の細い幅のマスクにより複数のエッチング面積に分割すること、あるいは開口面積の大きい凹部の形成と開口面積の小さい凹部の形成を別のドライエッチング工程で行い、それぞれの工程において加工の対象とならない部分をマスクによって覆うことが有効である。

【0009】

【作用】SF₆とO₂の混合ガスを用いたドライエッチングの反応機構は、本出願人の特許出願に係る特開平2-275626号公報に記載されているように、次のように考えられる。まず、SF₆とO₂のそれぞれの反応ガスは、プラズマ中で解離し、FラジカルとOラジカルが生成される。つぎに、プラズマ中のOラジカルが被加工部ウェットエッチングのSi原子と反応し、中間生成物としてSiOが生成される。この中間生成物のSiOとFラジカルとが反応し、SiF₄が生成される。このSiF₄は沸点が非常に低いため、自然にガスとなって反応室外に排気される。この反応機構によりシリコンが加工される。その際、反応生成物が残らないため、微細な加工が可能に

4

なる。そして、形成された凹部の側壁はプラズマ中に残存するOラジカル等によって一時的に酸化され、このときの一時的な酸化物により凹部側壁は保護されながらエッチングが進行する。この状態はシリコン基板に所定の形状の凹部ないし貫通孔が形成されるまで保持されるので、凹部あるいは貫通孔の側壁はシリコン基体の主面に垂直になる。

【0010】また、このようなSF₆+O₂の混合ガスを用いたドライエッチングにおいてはシリコンとシリコン酸化膜との選択比が100以上もある。従って、エッチングで形成される凹部のシリコン基体中に埋設されているエッチングストップ層のシリコン酸化膜に到達したことを、例えばプラズマの発光スペクトル強度をモニターすることで検知し、その点を基準にして、さらにオーバーエッチさせることで所定の大きさの垂直な側壁をもつ凹部を形成することができる。

【0011】

【実施例】以下、図を引用して本発明のいくつかの実施例について説明する。図1(a)~(c)に示した実施例では、まず厚さ約300μmのシリコン基板1の両面に、厚さ約1μmのアルミニウムからなる薄膜を形成し、さらに、シリコン基板1の被加工部が露出するように燐硝酸等のエッチング液を用いてSi基板上にAl薄膜4のマスクパターンを形成する(図1(a))。つぎに、図5に示すような陽極結合方式の平行平板型ドライエッチング装置を用いて片面ずつエッチングを行う。この装置は、本出願人の特許出願に係る特開平2-280324号公報に記載されているもので、反応室31内にステージを兼ねる下部電極32と5~100mmの範囲にある距離離れて上部電極33が対向している。反応室の底板34の周辺部に分散して設けられた排気管35が底板と平行に下部電極32の中心に向かって開口している。上部電極33にはマッチングチューナ36を介して高周波電源37が接続されている。反応室31の頂部38と上部電極33の接続体39との間隙40が反応ガス41の導入口となる。このような陽極結合方式の平行平板型ドライエッチング装置の反応室31内の下部電極ステージ32上に、図1(a)に示したようなAlマスクパターン4を形成したSi基板1を置き、反応室31内にSF₆とO₂を7対3の割合で混合した反応ガス41を導入口40から流入させ、反応室31内を約50Paの圧力に保持し、下部電極32と対向した上部電極33との間に約1W/cm²の高周波電力を印加して、露出した被加工部のシリコンとプラズマ42内に残存するラジカルや反応ガスイオンとの間に物理化学的反応等を起こさせることで基板1の被加工部からSiを除去し、Si基板1に厚さ1μmだけの底部11を残して、所定の大きさで側壁が垂直な形状をもつ凹部51、52を形成する(図1(b))。なお、SF₆とO₂の混合ガス中のO₂の混合比は0~60%の範囲で、反応室内の圧力は5~150Paの範囲で、また高周波電力は0.3~2.0W/cm²の範囲で選定できる。つぎに、シリコン基板1を

裏返して凹部51、52が下方に来るように電極ステージ32上に置き、Si基板を同様に加工して所定の大きさで側壁が垂直な貫通孔53を形成する(図1(c))。これにより厚さ10 μ m、幅130 μ mの可動電極23と厚さ20 μ m、高さ300 μ mの固定電極25が10 μ mの間隙をおいて組合わされた状態の可動部と固定部をもつ櫛歯式アクチュエータの複数個を同時に形成できる。可動部のミラー部22は凹部51に対向して形成される。

【0012】上の実施例では最初に深掘り加工を行って凹部51、52を形成し、次に浅掘り加工を行って貫通孔53を形成したが、逆に浅掘り加工を先に行ってもよい。また、深さ10 μ m程度の浅掘り加工は、陰極結合方式のドライエッチング装置を用いた反応性イオンエッチング(RIE)方法によっても加工できる。このように加工順序の入れ換えあるいは加工方法の変更が可能なことは、以下の各実施例においても同様である。

【0013】図6(a)～(c)に示した実施例では、二面上のマスクパターンはシリコン酸化膜2で弗酸などのエッチング液により形成し、他面上のマスクパターンはAl膜4で形成する(図6(a))。こうして図1について述べた実施例と同様に凹部51、52貫通孔53を加工し、可動電極23および固定電極25をもつ櫛歯式アクチュエータを形成する(図6(b)、(c))。シリコン酸化膜2をマスクに用いると、Alマスクに較べてサイドエッチング量が半分になるため、この実施例のように可動電極23と固定電極25の間の狭く長い貫通孔53を形成する浅掘り加工のためのマスクに用いることが有利である。また、ミラー部22に半導体素子を集積する場合には、Alマスクを用いることができないので絶縁性のシリコン酸化膜を用いることが有利である。ただし、シリコン酸化膜2は、SF₆とO₂の混合ガスを用いたドライエッチングにおけるSiとの選択比がAlに比して小さいため、深い凹部の加工や厚い基板への貫通孔の加工における両面のマスクに用いることはできないが、200 μ m程度以下の厚さのシリコン基板への加工の際には両面のマスクに用いることができる。

【0014】図7(a)～(c)はシリコン酸化膜をエッチングストップ層として用いた実施例を示す。この場合は、シリコン基板1の上にシリコン酸化膜2を介して厚さ1 μ mのシリコン層6が積層されている。このような基体は、2枚の単結晶シリコン板を酸化膜を介して密着させ、加熱してはり合わせたのち、必要に応じて研削によって所定の厚さにすることにより容易に作ることができる。この場合、両面にアルミニウムマスク4を設け(図(a))、上記の実施例と同様に深掘り加工(図7(b))および浅掘り加工(図7(c))で行うと、シリコンとシリコン酸化膜のドライエッチングにおける選択比が100以上あり、どの面からのエッチングもシリコン酸化膜2で停止する。従って、このあとシリコン酸化膜2をオーバーエッチングなどで除去すれば、所定の寸法、形状の固

定部と可動部の分離した櫛歯式アクチュエータが形成できる。この実施例においても、シリコン基板1の厚さが200 μ m以上あるときは、シリコン層6の加工のための浅掘り側のマスクをシリコン酸化膜で形成することも有効である。また厚さ200 μ m以下の場合は両面のマスクをシリコン酸化膜に置き換えてもよい。

【0015】図8(a)～(c)に示した実施例では、シリコン酸化膜のエッチングストップ層を有する基体を、例えば厚さ300 μ mのシリコン基板1の一面上にシリコン酸化膜を形成し、その上に厚さ10 μ mの多結晶シリコン層7を積層することによって形成する。このあと、両面にアルミニウム膜のマスク4を形成し(図8(a))、上記の実施例と同様にドライエッチングによる加工を行うと、図7(c)と同様に所定の寸法、形状の凹部51、52、貫通孔53が形成できる(図8(b)、(c))。

【0016】さて、櫛歯式アクチュエータがより小型化されると、ドライエッチングの際に被エッチング面積が異なる部分でエッチレートが異なることがある。すなわち、被エッチング面積が大きい部分のエッチレートが他の部分のそれより大きくなることもある。その効果が大きく効き、均一な深掘り加工が困難な場合がある。そこで、図9(a)～(d)に示す実施例では、ミラー部を残すために被エッチング面積の大きくなる被加工部8には、予めエッチング面積が幅の狭い多数の部分に区分されるようにマスク4を密に形成する(図9(a))。次に図1について述べた実施例と同様の条件で深掘り加工を行う(図9(b))。このとき予めエッチング面積を細かく区分した部分8は他の部分より速く加工されるが、マスクパターンが密であるため、狭い隔壁9が残留せず、所定の大きさで側壁が垂直な凹部51が形成される(図9(c))。そして続く浅掘り加工で図7(c)と同様の形状が得られる(図9(d))。また、図のようにシリコン酸化膜2のエッチングストップ層を設けた場合は、被エッチング面積が異なるため部分的にエッチング速度に差が生じても、このシリコン酸化膜で十分吸収され、所定の寸法の垂直凹部が形成できるという利点がある。

【0017】図10(a)～(e)の示す実施例では、深掘り加工側に最初に設けるAlマスク4のパターンは、被エッチング面積の大きい部分8には設けない(図10(a))。そして各実施例と同様に深掘り加工を行うと、部分8にのみ大きな凹部51が形成される(図10(b))。次に他の部分にもAlマスク4のパターンを形成すると共に凹部内部もAl薄膜4で覆い(図10(c))、再び深掘り加工を行い、凹部52を形成(図10(d))、さらに反対面からの浅掘り加工で貫通孔53を形成することにより櫛歯式アクチュエータを得る(図10(e))。

【0018】以上の図8、図9、図10に示した実施例においても、上述のようにAlマスク4を片面、あるいは両面共シリコン酸化膜マスク2に置き換えてもよいことは勿論である。

【0019】

【発明の効果】本発明によれば、SF₆とO₂混合ガスを用いたドライエッチングにより加工することにより、反応生成物が残留せず、垂直な側壁をもつ凹部ないし貫通孔が形成できるため、狭い間隙を介する可動電極と固定電極とが組合わされる櫛歯式アクチュエータを、一つのシリコン基体から組み合わされた状態で任意の大きさ、形状で作りだすことができ、設計に余裕が生じるので、センサやマイクロマシンの制作要求に応じた櫛歯式アクチュエータの小型化が可能になる。さらにシリコン酸化膜をエッチングストップ層として用いることにより、より高精度の加工も期待できる。また、大口径のシリコンウェーハから均一に多数のアクチュエータが同時に作成できるので、低価格化も達成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のシリコン基板加工工程を(a)～(c)の順に示す断面図

【図2】櫛歯式アクチュエータの概要を示す斜視図

【図3】従来のシリコン基板加工工程を(a)～(c)の順に示す断面図

【図4】従来の別のシリコン基板加工工程を(a)～(c)の順に示す断面図

【図5】本発明の実施例に用いるドライエッチング装置の断面図

10

【図6】本発明の別の実施例のシリコン基板加工工程を(a)～(c)の順に示す断面図

【図7】本発明の別の実施例のシリコン基板加工工程を(a)～(c)の順に示す断面図

【図8】本発明の別の実施例のシリコン基板加工工程を(a)～(c)の順に示す断面図

【図9】本発明の別の実施例のシリコン基板加工工程を(a)～(d)の順に示す断面図

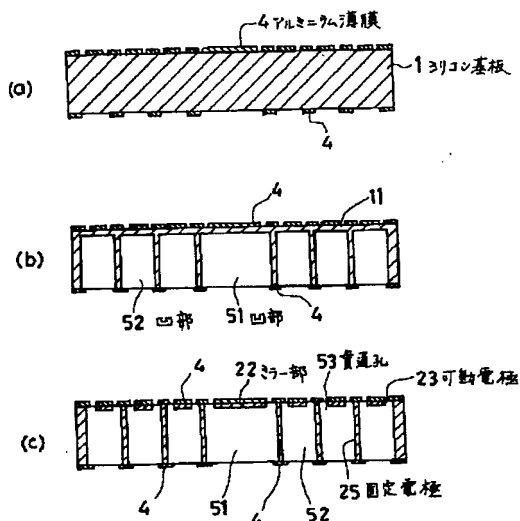
【図10】本発明の別の実施例のシリコン基板加工工程を(a)～(e)の順に示す断面図

【符号の説明】

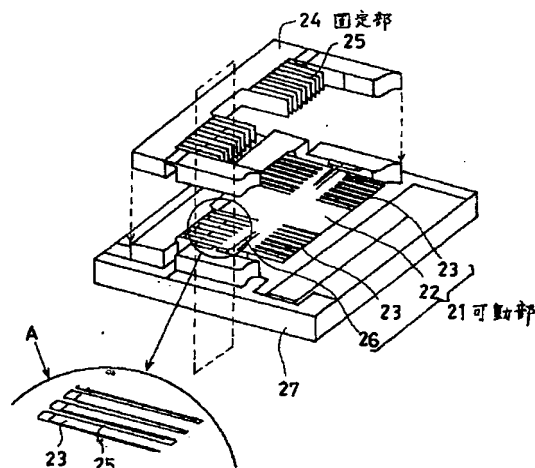
- 1 シリコン基板
- 2 シリコン酸化膜
- 21 可動部
- 22 ミラー部
- 23 可動電極
- 24 固定部
- 25 固定電極
- 4 アルミニウム薄膜
- 51 凹部
- 52 凹部
- 53 貫通孔
- 6 単結晶シリコン層
- 7 多結晶シリコン層

*

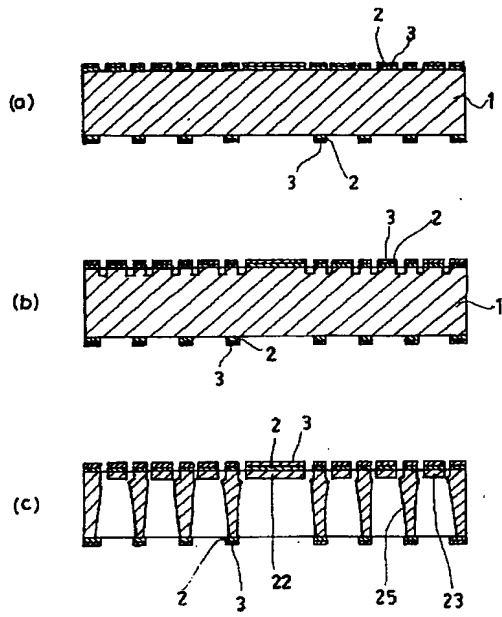
【図1】



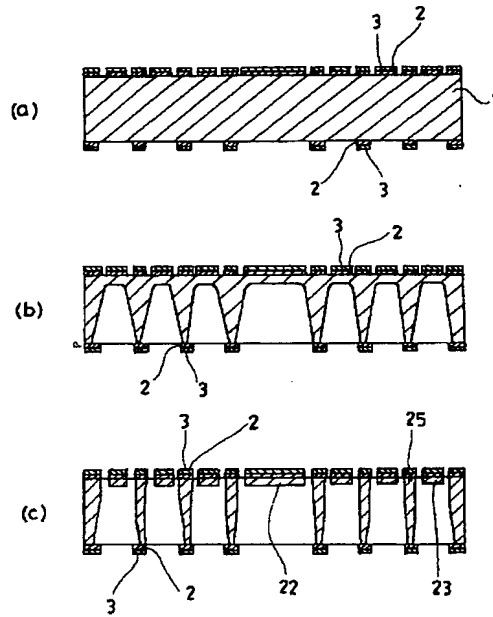
【図2】



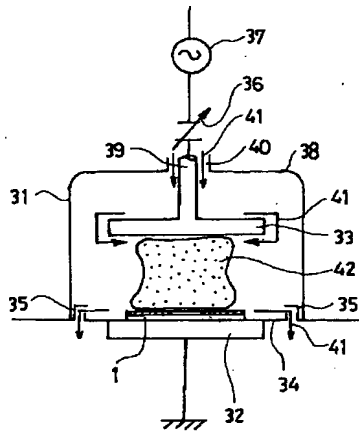
【図3】



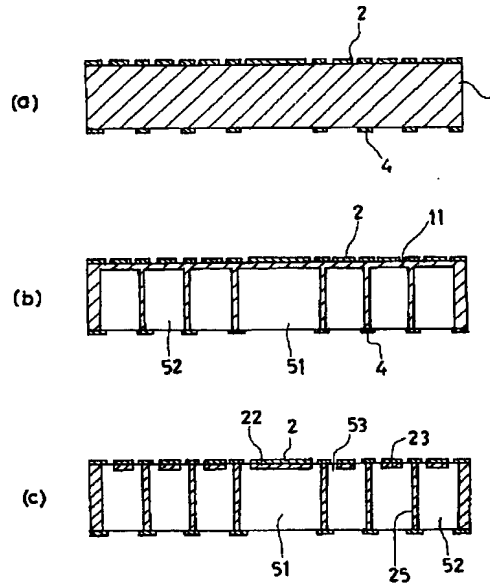
【図4】



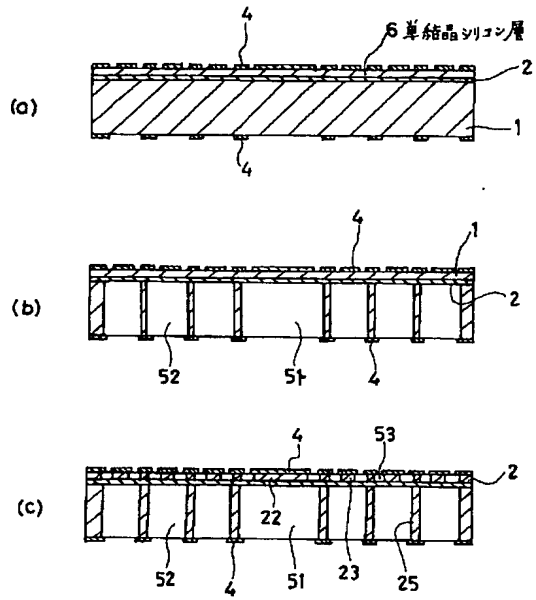
【図5】



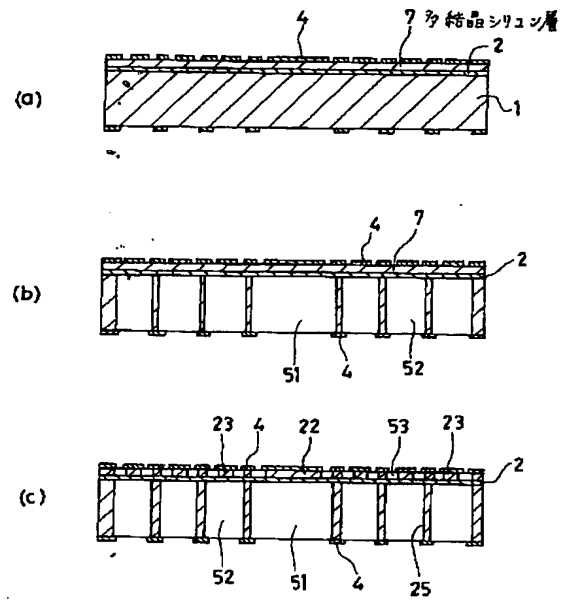
【図6】



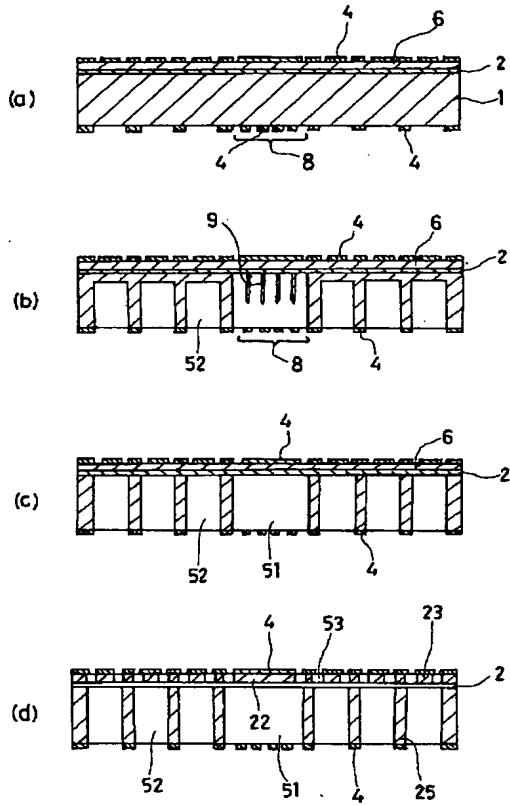
【図7】



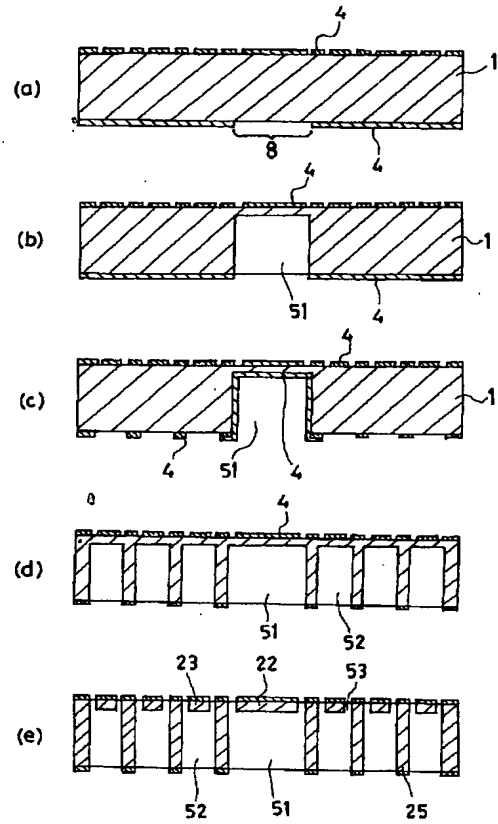
【図8】



【図9】



【図10】



PFS NO=92302734 CC=JP

集合をクリックすると一覧を10件単位で表示します。

DN : JP A2 5302182 (1993/11/16)

FAMILY MEMBERS

CC	PUBDAT	KD	DOC. NO.	CC	PR. DAT	YY	PR. NO.
JP	1993/11/16	A2	5302182	JP	1992/11/13	92	302734
JP	2001/06/18	B2	3178123				

+				JP	1992/02/25	92	36779
+JP	1993/11/16	A2	5302182				
+JP	2001/06/18	B2	3178123				

AB : CAN. 120<22>287851H DWT. C93-400625 PAJ. 180107C000123

S1	IP	2
S2	P	1
S3	U	0
